



汕头华汕电子器件有限公司

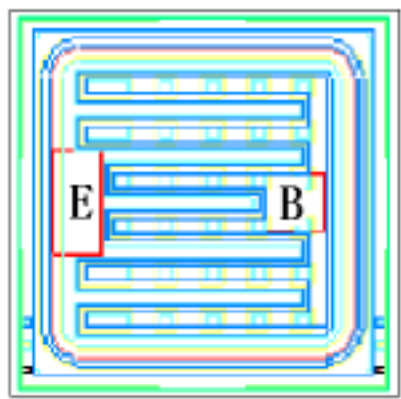
PNP SILICON TRANSISTOR

## 928S 晶体管芯片说明书

### 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）  
芯片代码：A080BJ-03  
芯片厚度：240±20μm  
管芯尺寸：800×800μm<sup>2</sup>  
焊位尺寸：B 极 124×124μm<sup>2</sup>；E 极 221×110μm<sup>2</sup>  
电极金属：铝  
背面金属：金  
典型封装：KSA928A，H928S

### 管芯示意图



### 极限值 (T<sub>a</sub>=25℃) (封装形式：TO-92)

T<sub>stg</sub>——贮存温度…………… -55~150℃  
T<sub>j</sub>——结温……………150℃  
P<sub>C</sub>——集电极耗散功率……………0.75W  
V<sub>CBO</sub>——集电极—基极电压……………-30V  
V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压……………-30V  
V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压……………-5V  
I<sub>C</sub>——集电极电流…………… -2A

### 电参数 (T<sub>a</sub>=25℃) (封装形式：TO-92)

| 参数符号                 | 符 号 说 明     | 最小值 | 典型值 | 最大值  | 单位  | 测 试 条 件                                          |
|----------------------|-------------|-----|-----|------|-----|--------------------------------------------------|
| BV <sub>CBO</sub>    | 集电极—基极击穿电压  | -30 |     |      | V   | I <sub>C</sub> =-100μA, I <sub>E</sub> =0        |
| BV <sub>CEO</sub>    | 集电极—发射极击穿电压 | -30 |     |      | V   | I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =0         |
| BV <sub>EBO</sub>    | 发射极—基极击穿电压  | -5  |     |      | V   | I <sub>E</sub> =-1mA, I <sub>C</sub> =0          |
| I <sub>CBO</sub>     | 集电极—基极截止电流  |     |     | -100 | nA  | V <sub>CB</sub> =-30V, I <sub>E</sub> =0         |
| I <sub>EBO</sub>     | 发射极—基极截止电流  |     |     | -100 | nA  | V <sub>EB</sub> =-5V, I <sub>C</sub> =0          |
| h <sub>FE</sub>      | 直流电流增益      | 100 |     | 320  |     | V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA     |
| V <sub>CE(sat)</sub> | 集电极—发射极饱和电压 |     |     | -2   | V   | I <sub>C</sub> =-1.5A, I <sub>B</sub> =-30mA     |
| V <sub>BE(on)</sub>  | 基极—发射极导通电压  |     |     | -1   | V   | V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA     |
| f <sub>T</sub>       | 特征频率        |     | 120 |      | MHz | V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA     |
| C <sub>ob</sub>      | 共基极输出电容     |     | 30  |      | pF  | V <sub>CB</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz |